

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

NEC.136

In Citation 1, an electrode pattern is formed, and part of the electrode pattern, or the gap between electrode patterns is used as a mark (or its use is possible) (particular reference is made to Figure 2).

In addition, it is also the same with Citation 2 (particular reference is made to Fig. 3 and Fig. 4).

The "obtained use" of a part of multiple marks as position determining marks, or as marks used to measure other components, is clear.

In addition, forming a metallic pattern on the same plane surface using the same marks, is commonly applied technology.

In Citation 3, standard marks are formed. The use of part of the standard marks as a position determining mark, or the use of another part as a mark used for measurements, is clear.

整理番号 47500137

発送番号 117500

発送日 平成13年 5月 8日 1 / 2

## 拒絶理由通知書

特許出願の番号	平成10年 特許願 第249331号
起案日	平成13年 4月18日
特許庁審査官	吉野 三寛 9814 2K00
特許出願人代理人	丸山 隆夫 様
適用条文	第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

### 理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記 of 刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

請求項1～7：引用文献1～3

備考：

引用文献1には、電極パターンが形成されており、前記電極パターンの部分や、電極パターン間の間隙は、マークとして「用いることが可能」である（図2を特に参照されたい）。

また、引用文献2についても同様である（図3、図6を特に参照されたい）。そして、前記複数のマークの一部を位置決めマーク、他の一部を測定用マーク

続葉有

続 葉

として「用い得る」ことは明らかである。

また、同一平面上の金属パターンを、同一のマスクを用いて形成することは、慣用されている技術である。

引用文献3には、基準マークが形成されている。前記基準マークの一部を位置決めマーク、他の一部を測定用マークとして用い得ることは明らかである。

引用文献等一覧

1. 特開平09-145965号公報
2. 特開平10-144998号公報
3. 特開平04-230050号公報

<補正等の示唆>

請求項中の記載が、活性層と位置決めマークとの相対位置を測定する測定方法とされているか、あるいは前記測定方法を含む半導体レーザの位置決め方法とされている場合には、上記拒絶の理由は解消する。補正に当たっては、この点も考慮されたい。なお、上記の補正等の示唆は法律的效果を生じさせるものではなく、拒絶理由を解消するための一案である。明細書及び図面をどのように補正するかは出願人が決定すべきものである。

この拒絶理由通知書の内容に関するお問い合わせ、またはこの出願について面接を希望されるときは、下記に御連絡下さい。

特許審査第一部 光デバイス 道祖土 (サイド) 新吾  
 TEL 03-3581-1101 内線 3253~3255  
 FAX 03-3580-6902